



Reference Number NBC1022022

Dispatch Number 248485

Dispatch Date July 14, 2004

### Notification of Reason(s) for Refusal

Patent Application No.	Patent application No. 2002-062670
Drafting Date	July 2, 2004
Examiner of JPO	Youichi OOSHIMA 9170 4L00
Representative / Applicant	Sakaki MORISHITA
Applied Provision	Patent Law Section 29 (1) and 29(2)

This application should be refused for the reason mentioned below. If the applicant has any argument against the reason, such argument should be submitted within 60 days from the date on which this notification was dispatched

### REASON

1. The invention in the claims listed below of the subject application should not be granted a patent under the provision of Patent Law Section 29(1)(iii) since it is an invention described in the publication(s) mentioned below which was distributed in Japan or foreign countries or an invention available to the public via electronic communication lines prior to the filing date of the subject application.
2. The invention in the claim listed below of the subject application should not be granted a patent under the provision of Patent Law Section 29(2) since it could have easily been made by persons who have common knowledge in the technical field to which the invention pertains, on the basis of the invention described in the publications listed below which were distributed in Japan or foreign countries or the invention available to the public via electronic communication lines prior to the filling of the subject application.

Note (See the list of cited documents etc. below.)

(With regard to the invention in claims 1-6)

Reasons 1, 2

Cited document No. 1

**Remarks:**

The cited document No. 1 (see especially table 1 and the associated description) discloses an organic EL electronic power supplying circuit provided with an aluminum wiring containing neodymium and having a specific resistance of  $4.75 \mu\Omega \cdot \text{cm}$ .

Further, the cited document No. 2 describes from the 33rd line to the 38th line on the left-hand section of in Page 7 that the specific resistance of  $\text{Al}_3\text{Nb}$  wiring depends on the relative magnitude of particle size and mean free path.

Accordingly, it is judged that the mean free path of alloy crystal in the wiring could be optimized to obtain a desired specific resistance in a given circuit.

The list of cited documents etc.

1. JP, 2000-349298, A
2. JP, 2000-277607, A



## 拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願 2002-062670
起案日	平成16年 7月 2日
特許庁審査官	大嶋 洋一 9170 4L00
特許出願人代理人	森下 賢樹 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

### 理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記 of 刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記 of 刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

#### <請求項1～6について>

- ・理由 1, 2
- ・引用文献 1
- ・備考

引用文献1の、特に表1及びその説明箇所には、ネオジウムを含有し、比抵抗  $4.75 \mu\Omega \cdot \text{cm}$  のアルミニウム配線構造を有する有機EL用電力供給回路が開示されている。

また、引用文献2の、特に第7頁左欄33～38行には、 $\text{Al}_3\text{Nb}$  配線において比抵抗は、粒子径と電子の平均自由行程との大小に依存する旨が記載されている。

したがって、配線構造の合金結晶の平均粒子径は、所定の回路において、所望の比抵抗となるように最適化し得るものと認められる。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

#### 引用文献等一覧

1. 特開2000-349298号公報
2. 特開2000-277607号公報

---

#### 先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野     IPC第7版  
                    H01L21/3205, H01L21/3213  
                    H01L21/768  
                    H01L21/28-H01L21/288  
                    H01L29/40-H01L29/51
- ・先行技術文献     特開平01-289140号公報  
                    特開2001-214261号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

#### <参考情報>

今回の拒絶理由において、各引用文献、先行技術文献等の、主にどのような技術的ポイントに着目しているかについて、参考情報として示します。意見書・補正書作成の際、参考情報としてご利用ください。

ただし、下記ポイントは、引用文献の一部の記載について例示的に示したに過ぎず、拒絶理由の対象となる範囲は、この記載に限定されず、あくまでも引用文献に記載された全範囲である点について、留意してください。

引用文献1：ネオジウムを含有し、比抵抗4.75 $\mu\Omega\cdot\text{cm}$ であるたアルミニウム配線の構造。

引用文献2：Al<sub>3</sub>Nb配線において比抵抗は、粒子径と電子の平均自由行程との大小に依存する技術的事項。

また、先行技術調査をする際、利用した代表的な検索条件（Fターム、キーワード等）を示します。本願発明の認定に関して、適切な認定が行われているかを確認するための参考情報等としてご利用下さい。

Fターム：5F033HH10, 5F033JJ10, 5F033LL08, 5F033KK08

キーワード：平均自由工程(MEAN FREE PATH), ランタノイド(Lanthanid)、ネオジウム (Neodymium)

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ(例:引用文献の番号違い等)、  
または技術説明等の面接の御希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第三部 半導体集積回路

審査官 大嶋 洋一

TEL. 03(3581)1101 内線3498

FAX. 03(3501)0673